CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN CHỨC DANH: PHÓ GIÁO SƯ

Mã hồ sơ: .....

(Nội dung đúng ở ô nào thì đánh dấu vào ô đó: ; Nội dung không đúng thì để trống: □)

Đối tượng đăng ký: Giảng viên □; Giảng viên thỉnh giảng ☑

Ngành: Vật lý; Chuyên ngành: Vật lý Chất rắn

A. THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Họ và tên người đăng ký: Nguyễn Trần Thuật

2. Ngày tháng năm sinh: 16/09/1980; Nam ☑; Nữ □; Quốc tịch: Việt Nam;

Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không

3. Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam:

4. Quê quán: xã Thắng Lợi, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội

5. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 20B, ngách 144/8, phố Quan Nhân, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

6. Địa chỉ liên hệ: Phòng 1405, tòa nhà Golden Palace, đường Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

Điện thoại nhà riêng:.....; Điện thoại di động: 0985516980; E-mail: thuatnt@vnu.edu.vn

7. Quá trình công tác (công việc, chức vụ, cơ quan):

Từ năm 2009 đến năm 2011, Nghiên cứu viên, Phó trưởng sau đó Trưởng bộ phận nghiên cứu phát triển, Phòng thí nghiệm Công nghệ nano, Đại học Quốc gia TPHCM

Từ năm 2012 đến năm 2013, Nghiên cứu viên, Trung tâm Nano và Năng lượng, Đại học Quốc gia Hà Nội

Từ năm 2014 đến năm 2019, Nghiên cứu viên sau đó Nghiên cứu viên chính, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

Chức vụ hiện nay: Nghiên cứu viên chính; Chức vụ cao nhất đã qua: Trưởng bộ phận Nghiên cứu và Phát triển

Cơ quan công tác hiện nay: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

Địa chỉ cơ quan: 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại cơ quan: 02435406136

Thỉnh giảng tại cơ sở giáo dục đại học (nếu có):

- Trường Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

- Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội.

- Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

- Trường Đại học Việt Nhật, Đại học Quốc gia Hà Nội

8. Đã nghỉ hưu từ tháng ..... năm .....

Nơi làm việc sau khi nghỉ hưu (nếu có): .....

Tên cơ sở giáo dục đại học nơi hợp đồng thỉnh giảng 3 năm cuối (tính đến thời điểm hết hạn nộp hồ sơ):

- Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội, Viện Hàn lâm khoa học và Công nghệ Việt Nam.

- Trường Đại học Việt Nhật, Đại học Quốc gia Hà Nội.

9. Trình độ đào tạo:

- Được cấp bằng ĐH ngày 17 tháng 03 năm 2005, ngành: Kỹ sư đa ngành, chuyên ngành: Bán dẫn và Ứng dụng

Nơi cấp bằng ĐH (trường, nước): Trường Bách khoa (Ecole Polytechnique), Pháp

- Được cấp bằng ThS ngày 17 tháng 03 năm 2005, ngành: Vật lý Ứng dụng, chuyên ngành: Điện tử và Quang điện tử

Nơi cấp bằng ThS (trường, nước): Trường Bách khoa (Ecole Polytechnique), Pháp

- Được cấp bằng TS ngày 20 tháng 05 năm 2009, ngành: Vật lý

Nơi cấp bằng TS (trường, nước): Trường Bách khoa (Ecole Polytechnique), Pháp

- Được cấp bằng TSKH ngày … tháng … năm ..., ngành: ……., chuyên ngành: …….

Nơi cấp bằng TSKH (trường, nước): .....

10. Đã được bổ nhiệm/công nhận chức danh PGS ngày …… tháng ……. năm …… ,

ngành: .....

11. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh PGS tại HĐGS cơ sở: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

12. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh PGS tại HĐGS ngành, liên ngành: Vật lý

13. Các hướng nghiên cứu chủ yếu:

- Năng lượng mặt trời, cụ thể là ứng dụng năng lượng mặt trời nói chung và quang năng nói riêng cho việc chiếu sáng trong nhà vào ban ngày.
- Vật liệu hợp chất bán dẫn oxit, cụ thể là loại hợp chất delafossite ABO_2, ứng dụng trong pin mặt trời loại màng mỏng với chi phí thấp và trong cảm biến ảnh hồng ngoại nhiệt,
- Vật liệu perovskite kim loại hữu cơ halogen, cụ thể là ứng dụng trong pin mặt trời và các linh kiện quang điện tử, lượng tử tiên tiến.
- Vật liệu cấu trúc lõi polymer vỏ kim loại quý, cụ thể là ứng dụng trong màng dẫn điện bất đẳng hướng.

14. Kết quả đào tạo và nghiên cứu khoa học:

- Đã hướng dẫn 07 HVCH đã được nhận bằng hoặc quyết định công nhận học vị ThS;

- Đã hoàn thành 02 đề tài NCKH cấp Bộ/Đại học Quốc gia;

- Đã hoàn thành 01 đề tài NCKH cấp Nhà nước;

- Đã hoàn thành 01 đề tài NCKH cấp Quỹ nghiên cứu Khoa học cơ bản Quốc gia (Nafosted);

- Đã công bố 55 bài báo và báo cáo KH, trong đó 27 bài báo KH trên tạp chí quốc tế có uy tín;

- Đã được cấp 02 bằng sáng chế;

- Số lượng sách đã xuất bản ....., trong đó …….. thuộc nhà xuất bản có uy tín;

- Số lượng tác phẩm nghệ thuật, thành tích thể dục, thể thao đạt giải thưởng quốc gia, quốc tế: ……

15. Khen thưởng (các huân chương, huy chương, danh hiệu): .....

16. Kỷ luật (hình thức từ khiển trách trở lên, cấp ra quyết định, số quyết định và thời hạn hiệu lực của quyết định): Không có

B. TỰ KHAI THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH GIÁO SƯ/PHÓ GIÁO SƯ

1. Tiêu chuẩn và nhiệm vụ của nhà giáo (tự đánh giá):

- Thâm niên giảng dạy: 6 năm đủ giờ chuẩn giảng dạy.

- Thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học: 02 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Đại học Quốc gia, 01 đề tài cấp nhà nước, 01 đề tài nghiên cứu cơ bản Quỹ Nghiên cứu khoa học Quốc gia (Nafosted).

- Hướng dẫn thạc sĩ: 07 thạc sĩ đã được nhận bằng/quyết định công nhận học vị thạc sĩ.

- Hướng dẫn NCS: 01 với vai trò hướng dẫn phụ.

- Công trình công bố: 57 công trình trong đó 27 công trình khoa học công bố tại các tạp chí khoa học uy tín, 2 bằng sáng chế, và các công trình khoa học khác.

2. Thời gian tham gia đào tạo, bồi dưỡng từ trình độ đại học trở lên:

- Tổng số 6 năm.

- Khai cụ thể ít nhất 6 năm học, trong đó có 3 năm học cuối tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ

TT	Năm học	Hướng dẫn NCS		Số lượng ThS/CK2/ BSNT đã hướng dẫn	Số đồ án, khóa luận tốt nghiệp ĐH đã HD	Số lượng giờ giảng dạy trực tiếp trên lớp		Tổng số giờ giảng trực tiếp/giờ quy đổi/Số giờ định mức
		Chính	Phụ			ĐH	SĐH	
1	2014 - 2015				2 Chính 1 Phụ	80h	40h	120/58/135
2	2015 - 2016			1 Phụ	4 Chính 4 Phụ	240h	40h	280/156/135
3	2016 - 2017			1 Chính	2 Chính 4 Phụ	80h	40h	120/82/135
3 năm học cuối								
4	2017 - 2018			1 Chính	2 Chính 2 Phụ	160h	86h	236/113/135
5	2018 - 2019			1 Chính	1 Chính 1 Phụ	278h	0h	278/33/135
6	2019 -			1 Phụ		120h	0h	120/23/135

	2020							

3. Ngoại ngữ:

3.1. Ngoại ngữ thành thạo phục vụ chuyên môn: Anh, Pháp

a) Được đào tạo ở nước ngoài ☑ :

- Học ĐH ☑; Tại nước Pháp; Từ năm 2001 đến năm 2003
- Bảo vệ luận văn ThS ☑; Tại nước Pháp năm 2004
- Bảo vệ luận án TS ☑; Tại nước Pháp năm 2008

b) Được đào tạo ngoại ngữ trong nước □ :

- Trường ĐH cấp bằng tốt nghiệp ĐH ngoại ngữ: .....số bằng: .....; năm cấp:.....

c) Giảng dạy bằng tiếng nước ngoài ☑:

- Giảng dạy bằng ngoại ngữ : Tiếng Anh
- Nơi giảng dạy (cơ sở đào tạo, nước):

  + Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Việt Nam.

d) Đối tượng khác □ ; Diễn giải: .....

3.2. Tiếng Anh (văn bằng, chứng chỉ): .....

4. Hướng dẫn NCS, HVCH/CK2/BSNT đã được cấp bằng/có quyết định cấp bằng

TT	Họ tên NCS hoặc HVCH/ CK2/ BSNT	Đối tượng		Trách nhiệm hướng dẫn		Thời gian hướng dẫn từ .... đến ...	Cơ sở đào tạo	Ngày, tháng, năm được cấp bằng/có quyết định cấp bằng
		NCS	HVCH/ CK2/ BSNT	Chính	Phụ			
1	Nguyễn Đình Nghĩa		✓	✓		06/2011 - 12/2012	Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN	7/5/2013
2	Trần Đặng Bảo Ấn		✓	✓		01/2013 - 6/2013	Trường Đại học Bách khoa TPHCM, ĐHQG TPHCM	20/7/2013
3	Nguyễn Minh Tú		✓		✓	4/2015 - 01/2016	Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN	28/3/2016
4	Đỗ Ngọc Hiệu		✓	✓		11/2015 - 07/2017	Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN	28/6/2017
5	Trần Ngọc Lân		✓	✓		12/2017 - 7/2018	Trường Đại học Việt Nhật, ĐHQGHN	7/01/2018

6	Phan Vũ Thị Vân		✓	✓		7/2017 - 12/2018	Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN	27/12/2018
7	Lý Văn Nam		✓		✓	5/2018 – 8/2019	Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN	26/8/2019

5. Biên soạn sách phục vụ đào tạo đại học và sau đại học

TT	Tên sách	Loại sách (CK, GT, TK, HD)	Nhà xuất bản và năm xuất bản	Số tác giả	Chủ biên	Phần biên soạn (từ trang ... đến trang)	Xác nhận của cơ sở GDĐH (số văn bản xác nhận sử dụng sách)
Không có							

Trong đó, số lượng (ghi rõ các số TT) sách chuyên khảo do nhà xuất bản có uy tín xuất bản và chương sách do nhà xuất bản có uy tín trên thế giới xuất bản sau PGS/TS: .....

Lưu ý:

- Tách thành 2 giai đoạn: Trước và sau khi bảo vệ luận án TS đối với ứng viên chức danh PGS; trước và sau khi được công nhận chức danh PGS đối với ứng viên chức danh GS;

- Chỉ kê khai các sách được phép xuất bản (Giấy phép XB/Quyết định xuất bản/số xuất bản), nộp lưu chiểu, ISBN (nếu có).

- Các chữ viết tắt: CK: sách chuyên khảo; GT: sách giáo trình; TK: sách tham khảo; HD: sách hướng dẫn; phần ứng viên biên soạn cần ghi rõ từ trang.... đến trang..... (ví dụ: 17-56; 145-329).

6. Thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã nghiệm thu

TT	Tên nhiệm vụ khoa học và công nghệ (CT, ĐT...)	CN/PCN/TK	Mã số và cấp quản lý	Thời gian thực hiện	Thời gian nghiệm thu (ngày, tháng, năm)/Xếp lại kết quả
Sau khi bảo vệ học vị TS (từ năm 2008 trở đi)					
1	ĐT: Chế tạo ăng-ten cho thẻ nhận dạng bằng sóng Radio	CN	B2009-32-01 Đại học Quốc gia	01/2009 - 12/2009	25/11/2010/Đạt
2	ĐT: Chế tạo thẻ nhận dạng sử dụng ăng-ten sóng radio bằng công nghệ nano	CN	07/2009/HĐ-ĐTĐL Nhà nước	6/2009 - 6/2011	21/8/2012/Khá
3	ĐT: Nghiên cứu chế tạo màng mỏng dạng delafossite CuFeO2	CN	QG.14.24 Đại học Quốc gia	4/2014 - 4/2016	4/8/2016/Tốt
4	ĐT: Nghiên cứu chế tạo vật liệu perovskite vô cơ – hữu cơ ứng dụng cho lớp hấp thụ của pin mặt trời tiếp	CN	103.02-2014.81 Nafosted	3/2015 - 3/2018	27/6/2018/Đạt

	giáp dị thể				

Lưu ý:

- Tách thành 2 giai đoạn: Trước và sau khi bảo vệ luận án TS đối với ứng viên chức danh PGS; trước và sau khi được công nhận chức danh PGS đối với ứng viên chức danh GS;

- **Các chữ viết tắt:** CT: Chương trình; ĐT: Đề tài; CN: Chủ nhiệm; PCN: Phó chủ nhiệm; TK: Thư ký.

7. Kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ đã công bố (bài báo khoa học, sáng chế/giải pháp hữu ích, giải thưởng quốc gia/quốc tế)

7.1. Bài báo khoa học đã công bố

TT	Tên bài báo/báo cáo KH	Số tác giả	Là tác giả chính	Tên tạp chí hoặc kỷ yếu khoa học/ISSN hoặc ISBN	Loại Tạp chí quốc tế uy tín: ISI, Scopus (IF, Qi)	Số lần trích dẫn (không tính tự trích dẫn)	Tập, số, trang	Năm công bố
Sau khi bảo vệ học vị TS (từ năm 2008 trở đi)								
Các bài báo đăng tại các tạp chí quốc tế uy tín								
1.	Simulation of coupling optical modes in 1D photonic crystals for optoelectronic applications	2	✓	Journal of Science: Advanced Materials and Devices	SCIE/ SCOPUS, Q1[1] (2019)		5, 142	2020
2.	Growth and morphology control of CH3NH3PbBr3 crystals	8	✓	Journal of Materials Science	SCI, Q1, IF 3.442 (2018)		54, 14797	2019
3.	Detection analysis limit of nonlinear characteristics of DNA sensors with the surface modified by polypyrrole nanowires and gold nanoparticles	6		Journal of Science: Advanced Materials and Devices	SCIE/ SCOPUS, Q1 (2019)	1	3, 129	2018
4.	Optical and electrical responses of magnetron-sputtered amorphous Nb-doped TiO2 thin films annealed at low temperature	9		Physica B: Condensed Matter	SCI, Q2[2], IF 1.874 (2018)	4	532, 200	2018

[1] Bài báo thuộc lĩnh vực "Electronic, Optical and Magnetic Materials"
[2] Bài báo thuộc lĩnh vực "Electronic, Optical and Magnetic Materials"

5.	Synthesis of organo tin halide perovskites via simple aqueous acidic solution-based method	5	✓	Journal of Science: Advanced Materials and Devices	SCIE/ SCOPUS, Q1 Error! Bookmark not defined. (2019)	5	3, 471	2018
6.	Selected-area growth of nickel micropillars on aluminum thin films by electroless plating for applications in microbolometers	6	✓	Journal of Science: Advanced Materials and Devices	SCIE/ SCOPUS, Q1 Error! Bookmark not defined. (2019)	1	2, 192	2017
7.	Synthesis of tantalum-doped tin oxide thin films by magnetron sputtering for photovoltaic applications	9	✓	Journal of Electronic Materials	SCI, Q2[3], IF 1.676 (2018)	15	46, 3622	2017
8.	Three-photon absorption induced photoluminescence in organo-lead mixed halide perovskites	13	✓	Journal of Electronic Materials	SCI, Q2[3], IF 1.676 (2018)	3	46, 3667	2017
9.	Fabrication of copper(I) bipyridyl complex based dye sensitized solar cells	7	✓	Journal of Electronic Materials	SCI, Q2[3], IF 1.676 (2018)	2	46, 3639	2017
10.	Thermoelectric micro-refrigerator based on bismuth/antimony telluride	7		Journal of Electronic Materials	SCI, Q2[3], IF 1.676 (2018)	2	46, 3660	2017
11.	Stimulated absorption of light in bosonic cascades of excitons	5		Superlattices and Microstructures	SCI, Q2 2.385 (2018)	3	109, 454	2017
12.	Optical and structural study of organometal halide materials for applications in perovskite-based solar cells	9	✓	Journal of Electronic Materials	SCI, Q2[3], IF 1.676 (2018)	10	45, 2322	2016
13.	Optical study of cuprous oxide and ferric oxide based materials for	9	✓	Journal of Electronic Materials	SCI, Q2[3], IF 1.676 (2018)	2	45, 2407	2016

[3] Bài báo thuộc lĩnh vực "Electronic, Optical and Magnetic Materials"

	applications in low cost solar cells,							
14.	Optimization of synthesis of ZnO:Al as n-type transparent conductive layer for oxide-semiconductor-based solar cells	10	✓	Journal of Electronic Materials	SCI, Q2[3], IF 1.676 (2018)	4	45, 2442	2016
15.	Fabrication of PDMS-based microfluidic devices: application for synthesis of magnetic nanoparticles	8		Journal of Electronic Materials	SCI, Q2[3], IF 1.676 (2018)	7	45, 2576	2016
16.	Doped semiconductor nanocrystal junctions	4		Journal of Applied Physics	SCI, Q2, IF 2.328 (2018)	10	144, 204305	2013
17.	Effect of temperature in electrochemical texturizing of multicrystalline silicon in KOH solution	5		International Journal of Nanotechnology	SCI, Q4, IF 0.578 (2018)		10, 288	2013
18.	Development and application investigation of an ICSHG 532 nm diode-pumped solid-state laser system	5		Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology	ESCI/ SCOPUS, Q1[4] (2018)		2, 45008	2011
19.	A new platform for RFID research in Vietnam	6		Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology	ESCI/ SCOPUS, Q1[5] (2018)	10	1, 45015	2010
20.	Mapping charge transfers between quantum levels using noncontact atomic force microscopy	8		Physical Review B	SCI, Q1, IF 3.738 (2018)	12	82, 73302	2010
Các bài báo đăng trên các tạp chí khoa học quốc gia								
21.	Growth of single crystals of methylammonium lead mixed halide perovskites	5	✓	Communications in Physics		3	28, 237	2018
22.	Electrical properties of Nb-doped TiO2	5		VNU Journal of Science:			33, 44	2017

[4] Bài báo thuộc lĩnh vực "Electrical and Electronic Engineering"
[5] Bài báo thuộc lĩnh vực "Industrial and Manufacturing Engineering"

	thin films deposited by co-sputtering process			Mathematics - Physics				
23.	Fabrication of organolead iodide perovskite solar cells with niobium-doped titanium dioxide as compact layer	10	✓	Communications in Physics			27, 121	2017
24.	Characterization of ZnO:Al deposited by co-sputtering for transparent conductive electrodes	8	✓	Communications in Physics			25, 341	2015
25.	Study on the deposition of amorphous silicon and ITO thin films for heterojunction solar cell application	7		Tạp chí Phát triển khoa học và Công nghệ, Đại học Quốc gia Tp Hồ Chí Minh			16, 101	2013
26.	Improvement of short circuit current of mono crystalline silicon solar cells	6		Tạp chí Phát triển khoa học và Công nghệ, Đại học Quốc gia Tp Hồ Chí Minh			16, 48	2013
Các báo cáo đăng trên kỷ yếu hội nghị quốc tế								
27.	Synthesis of two-dimensional hybrid organic inorganic perovskite materials for applications in solar cells and optoelectronics	8	✓	Vietnam – Japan Science and Technology Symposium – Towards Sustainable Development Proceedings, VJST2019, 5/2019, Hà Nội			106	2019
28.	Synthesis of poly(methyl methacrylate) conductive core shell microspheres by polymerization and electroless plating of silver	5	✓	Vietnam – Japan Science and Technology Symposium – Towards Sustainable Development Proceedings, VJST2019, 5/2019, Hà Nội			110	2019
29.	Fabrication of a thermoelectric cooler based on bismuth/antimony telluride	9		Proceeding of The 6th International workshop on Nanotechnology and Application 2017, IWNA2017			247	2017

30.	Developing innovative solar energy products in vietnam: An example of issues and solutions	2		International Conference on Financing For Innovation, Entrepreneurship and Renewable Energy Development, 16-17th August 2017, Hanoi City, Vietnam			30	2017
31.	Synthesis of silicon nanocrystals by cold plasma for application in optoelectronics and nanoelectronics	2		Plasma Application and IIybrid Functionally Materials			26, 31	2017
32.	Fabrication of optical band-pass filter by electron-beam ion assisted deposition evaporation technique	4		Proceedings of the third international conference on advanced materials and nanotechnology, ICAMN2016			178	2016
33.	Optimization for analytical model of rear side point contact UMG-Si solar cells	5		Proceeding of The 4th International workshop on Nanotechnology and Application 2013, IWNA2013, Vung Tau , Viet Nam			163	2013
34.	Improving radiation characteristics of UHF RFID antennas by zigzag structures	8	✓	Proceedings of The 2011 International Conference on Advanced Technologies for Communications (ATC-2011), Da Nang City, Vietnam		7	102	2011
35.	Design and fabrication of UHF RFID tag	7	✓	Proceedings of The 2011 International Conference on Advanced Technologies for Communications (ATC-2011), Da Nang City, Vietnam		1	98	2011
36.	Contribution on UHF RFID antenna design and tag fabrication	9	✓	Proceedings of the IEEE International Conference on RFID – Technologies and		1	463	2011

				Applications (RFID-TA), Sitges, Barcelona, Spain				
37.	Deposition of hydrogenated amorphous and microcrystalline silicon by pecvd for thin film and heterojunction solar cells	5		Proceeding of The 3th International workshop on Nanotechnology and Application 2011, IWNA2011, Vung Tau, Vietnam			945	2011
38.	Planar antennas for UHF RFID passive tags	7		Proceedings of The 2011 International Symposium on Electrical-Electronics Engineering ISEE2011, Ho Chi Minh City, Vietnam			18	2011
39.	RFID UHF tag processing for demonstration purpose	5		Proceeding of The 2th International workshop on Nanotechnology and Application 2009, IWNA2009		3	588	2009
40.	Study of RFID antenna fabrication	6		Proceeding of The 2th International workshop on Nanotechnology and Application 2009, IWNA2009		3	584	2009
Các báo cáo đăng trên kỷ yếu hội nghị quốc gia								
41.	Chế tạo bề mặt siêu kỵ nước bằng phương pháp tạo vi cấu trúc phân tầng ứng dụng trong kênh dẫn sáng	5		Kỷ yếu hội nghị Vật lý chất rắn và Khoa học Vật liệu toàn quốc, SPMS 2017, tháng 10, Huế			727	2017
42.	Thiết kế và chế tạo hệ thấu hệ kính rắn ứng dụng trong thu nhận ánh sáng mặt trời	5		Kỷ yếu hội nghị Vật lý chất rắn và Khoa học Vật liệu toàn quốc, SPMS 2017, tháng 10, Huế			731	2017
43.	Tổng hợp và điều khiển hình thái bề ngoài đơn tinh thể lai cơ kim halogen perovskite cho ứng dụng quang điện tử	11	✓	Kỷ yếu hội nghị Vật lý chất rắn và Khoa học Vật liệu toàn quốc, SPMS 2017, tháng 10, Huế			556	2017
44.	Tổng hợp và ăn mòn	4	✓	Kỷ yếu hội nghị Vật			548	2017

	màng mỏng SiNx ứng dụng trong chế tạo các linh kiện vi cơ điện tử			lý chất rắn và Khoa học Vật liệu toàn quốc, SPMS 2017, tháng 10, Huế				
45.	Thiết kế mô phỏng hộp hấp thụ thành đa lớp ứng dụng trong cảm biến ảnh hồng ngoại nhiệt	6	✓	Kỷ yếu hội nghị Vật lý chất rắn và Khoa học Vật liệu toàn quốc, SPMS 2017, tháng 10, Huế			580	2017
46.	Chế tạo vật liệu hợp chất oxit kim loại có hệ số nhiệt điện trở cao bằng phương pháp phún xạ	7	✓	Kỷ yếu hội nghị Vật lý chất rắn và Khoa học Vật liệu toàn quốc, SPMS 2017, tháng 10, Huế			544	2017
47.	Chế tạo và mô phỏng cần chuyển đổi năng lượng dựa trên vật liệu áp điện không chì AlN	8		Kỷ yếu hội nghị Vật lý chất rắn và Khoa học Vật liệu toàn quốc, SPMS 2017, tháng 10, Huế			257	2017
48.	Tối ưu hóa và chế tạo điện cực điểm mặt sau của pin năng lượng mặt trời dựa trên đế UMG-Si	3		Kỷ yếu Hội nghị toàn quốc Vật lý Kỹ thuật và Ứng dụng lần III, Huế			456	2013
Trước khi bảo vệ học vị TS (đến năm 2008)								
Bài báo khoa học công bố tại các tạp chí quốc tế uy tín								
49.	Strong orange/red electroluminescence from hydrogenated polymorphous silicon carbon light-emitting device	6		Applied Physics Letters	SCI, Q1, IF 3.521 (2018)	19	92, 241114	2008
50.	Optimization of electroluminescent diodes based on pm-SiC:H deposited at low temperature	5		Materials Science and Engineering B	SCI, Q1, IF 3.507 (2018)	3	B147, 245	2008
51.	Low temperature plasma synthesis of silicon nanocrystals: a strategy for high deposition rate and efficient polymorphous and microcrystalline solar cells	6		Plasma Physics and Controlled Fusion	SCI, Q1, IF 2.799 (2018)	27	50, 124037	2008

52.	Synthesis of silicon nanocrystals in silane plasmas for nanoelectronics and large area electronic devices	6		Journal of Physics D: Applied Physics	SCI, Q1[6], 2.829 (2018)	70	40, 2258	2007
53.	Study of radial growth rate and size control of silicon nanocrystals in square-wave modulated silane plasmas	3	✓	Applied Physics Letters	SCI, Q1, IF 3.521 (2018)	18	91, 111501	2007
54.	Fluctuation microscopy evidence for enhanced nanoscale structural order in polymorphous silicon thin films	6	✓	Journal of Applied Physics	SCI, Q2, IF 2.328 (2018)	17	100, 94319	2006
55.	Optical study of disorder and defects in hydrogenated amorphous silicon carbon alloys	3	✓	Applied Physics Letters	SCI, Q1, IF 3.521 (2018)	8	87, 11903	2005

- Trong đó, số lượng bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học quốc tế uy tín mà UV là tác giả chính sau khi được công nhận PGS hoặc được cấp bằng TS: 10

Lưu ý: Tách thành 2 giai đoạn: Trước và sau khi bảo vệ luận án TS đối với UV chức danh PGS; trước và sau khi được công nhận chức danh PGS đối với UV chức danh GS.

7.2. Bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích

TT	Tên bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích	Tên cơ quan cấp	Ngày tháng năm cấp	Tác giả chính/ đồng tác giả	Số tác giả
1	Phương pháp và thiết bị thu nhận ánh sáng mặt trời	Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ, Hà Hội, Việt Nam	Số 20009, được cấp theo quyết định số 70223/QĐ-SHTT, ngày 08/10/2018	Tác giả chính (đứng đầu)	4
2	Thấu kính hội tụ kết nối với sợi quang và thiết bị thu nhận ánh sáng mặt trời sử dụng thấu kính này	Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ, Hà Hội, Việt Nam	Sáng chế số 24300, được cấp theo quyết định số 6109w/QĐ-SHTT, ngày 26/05/2020	Tác giả chính (đứng đầu)	5

[6] Bài báo thuộc lĩnh vực "Electronic, Optical and Magnetic Materials"

- Trong đó, các số TT của bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích được cấp sau khi được công nhận PGS hoặc được cấp bằng TS: 1, 2

7.3. Giải thưởng quốc gia, quốc tế (Tên giải thưởng, quyết định trao giải thưởng,...)

TT	Tên giải thưởng	Cơ quan/tổ chức ra quyết định	Số quyết định và ngày, tháng, năm	Số tác giả
Không có				

- Trong đó, giải thưởng quốc gia, quốc tế sau khi được công nhận PGS hoặc cấp bằng TS:...

7.4. Tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu thể dục thể thao đạt giải thưởng quốc gia, quốc tế

TT	Tên tác phẩm nghệ thuật, thành tích	Cơ quan/tổ chức công nhận	Văn bản công nhận (số, ngày, tháng, năm)	Cấp Quốc gia/Quốc tế	Số tác giả
Không có					

- Trong đó, các số TT tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu đạt giải thưởng quốc gia, quốc tế sau khi được công nhận PGS hoặc được cấp bằng TS: .....

8. Chủ trì hoặc tham gia xây dựng, phát triển chương trình đào tạo hoặc chương trình nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ của cơ sở giáo dục đại học đã được đưa vào áp dụng thực tế:

- Tổ trưởng tổ xây dựng và phát triển 01 chương trình đào tạo bậc cử nhân, ngành "Vật lý kỹ thuật và Điện tử" (Engineering Physics and Electronics), tại Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

9. Các tiêu chuẩn không đủ so với quy định, đề xuất công trình khoa học (CTKH) thay thế*:

a) Thời gian được bổ nhiệm PGS

Được bổ nhiệm PGS chưa đủ 3 năm, còn thiếu (số lượng năm, tháng): .....

b) Hoạt động đào tạo

- Thâm niên đào tạo chưa đủ 6 năm, còn thiếu (số lượng năm, tháng): .....

- Giờ giảng dạy

+ Giờ giảng dạy trực tiếp trên lớp không đủ, còn thiếu (năm học/số giờ thiếu): .....

+ Giờ chuẩn giảng dạy không đủ, còn thiếu (năm học/số giờ thiếu): .....

- Hướng dẫn chính NCS/HVCH,CK2/BSNT:

+ Đã hướng dẫn chính 01 NCS đã có Quyết định cấp bằng TS (UV chức danh GS) ☐

Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn hướng dẫn 01 NCS được cấp bằng TS bị thiếu: .....

+ Đã hướng dẫn chính 01 HVCH/CK2/BSNT đã có Quyết định cấp bằng ThS/CK2/BSNT (UV chức danh PGS) ☐

Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn hướng dẫn 01 HVCH/CK2/BSNT được cấp bằng ThS/CK2/BSNT bị thiếu: .....

c) Nghiên cứu khoa học

- Đã chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ (ƯV chức danh GS) ☐

Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ bị thiếu: .....
.....

- Đã chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở (ƯV chức danh PGS) ☐

Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở bị thiếu: ....
.....

- Không đủ số CTKH là tác giả chính:

+ Đối với ứng viên chức danh GS, đã công bố được: 03 CTKH ☐ ; 04 CTKH ☐

Đề xuất sách CK/chương sách XB quốc tế thay thế cho việc ƯV không đủ 05 CTKH là tác giả chính theo quy định: .....

+ Đối với ứng viên chức danh PGS, đã công bố được: 02 CTKH ☐

Đề xuất sách CK/chương sách XB quốc tế thay thế cho việc ƯV không đủ 03 CTKH là tác giả chính theo quy định: .....

(*) Các công trình khoa học thay thế không được tính vào tổng điểm.

C. CAM ĐOAN CỦA NGƯỜI ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN CHỨC DANH:

Tôi cam đoan những điều khai trên là đúng, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2020
Người đăng ký
(Ký và ghi rõ họ tên)

Nguyễn Trần Thuật